

光伏制造行业规范条件

为深入贯彻落实科学发展观，引导光伏制造行业加快转型升级，推动我国光伏产业持续健康发展，根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）和国家有关法律法规及产业政策，按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则，制定本规范条件。

一、生产布局与项目设立

（一）光伏制造企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。

（二）在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要生态功能保护区和生态环境敏感区、脆弱区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应逐步迁出。

（三）严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。对加强技术创新、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目，报行业主管部门及投资主管部门备案。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

二、生产规模和工艺技术

(一) 光伏制造企业应采用工艺先进、节能环保、产品质量好、生产成本低的生产技术和设备。

(二) 光伏制造企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立，具有独立法人资格；具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售后服务能力；具有省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质，每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的 3%且不少于 1000 万元人民币；申报符合规范名单时上一年实际产量不低于本条第(三)款产能要求的 50%。

(三) 光伏制造企业按产品类型应分别满足以下要求：

1. 多晶硅项目每期规模大于 3000 吨/年；
2. 硅锭年产能不低于 1000 吨；
3. 硅棒年产能不低于 1000 吨；
4. 硅片年产能不低于 5000 万片；
5. 晶硅电池年产能不低于 200MWp；
6. 晶硅电池组件年产能不低于 200MWp；
7. 薄膜电池组件年产能不低于 50MWp。

(四) 现有光伏制造企业及项目产品应满足以下要求：

1. 多晶硅满足《太阳能级多晶硅》(GB/T25074) 1 级品的要求；

2. 多晶硅片(含准单晶硅片)少子寿命大于 $2\mu s$ ，电阻率在 $1-3\Omega\cdot cm$ ，碳、氧含量分别小于 16 和 18PPMA；单晶硅

片少子寿命大于 $10\ \mu\text{s}$ ，电阻率在 $1\text{--}3\ \Omega\cdot\text{cm}$ ，碳、氧含量分别小于 10 和 18PPMA；

3. 多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别不低于 16%和 17%；

4. 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于 14.5%和 15.5%；

5. 硅基、铜铟镓硒（CIGS）、碲化镉（CdTe）及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于 8%、10%、11%、10%。

（五）新建和改扩建企业及项目产品应满足以下要求：

1. 多晶硅满足《硅多晶》（GB/T12963）2 级品以上要求；

2. 多晶硅片（含准单晶硅片）少子寿命大于 $2.5\ \mu\text{s}$ ，电阻率在 $1\text{--}3\ \Omega\cdot\text{cm}$ ，碳、氧含量分别小于 8 和 6PPMA；单晶硅片少子寿命大于 $11\ \mu\text{s}$ ，电阻率在 $1\text{--}3\ \Omega\cdot\text{cm}$ ，碳、氧含量分别小于 8 和 6PPMA；

3. 多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别不低于 18%和 20%；

4. 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件光电转换效率分别不低于 16.5%和 17.5%；

5. 硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于 12%、12%、13%、12%。

(六) 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件衰减率在 2 年内分别不高于 3.2%和 4.2%，25 年内不高于 20%；薄膜电池组件衰减率在 2 年内不高于 5%，25 年内不高于 20%。

三、资源综合利用及能耗

(一) 光伏制造企业和项目用地应符合国家已出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。

(二) 光伏制造项目能耗应满足以下要求：

1. 现有多晶硅项目还原电耗小于 80 千瓦时/千克，综合电耗小于 140 千瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于 60 千瓦时/千克，综合电耗小于 100 千瓦时/千克；

2. 现有硅锭项目平均综合能耗小于 9 千瓦时/千克，新建和改扩建项目小于 7 千瓦时/千克；如采用多晶铸锭炉生产单晶或高效多晶产品，项目平均综合能耗的增加幅度不得超过 0.5 千瓦时/千克；

3. 现有硅棒项目平均综合能耗小于 50 千瓦时/千克，新建和改扩建项目小于 45 千瓦时/千克；

4. 现有多晶硅片项目平均综合能耗小于 60 万千瓦时/百万片，新建和改扩建项目小于 55 万千瓦时/百万片；现有单晶硅片项目平均综合能耗小于 40 万千瓦时/百万片，新建和改扩建项目小于 35 万千瓦时/百万片；

5. 电池项目平均综合能耗小于 15 万千瓦时/MWp；

6. 晶硅电池组件项目平均综合能耗小于 8 万千瓦时/MWp；薄膜电池组件项目平均能耗小于 50 万千瓦时/MWp。

（三）光伏制造项目生产水耗应满足以下要求：

1. 多晶硅项目水循环利用率不低于 95%；
2. 硅片项目水耗低于 1400 吨/百万片；
3. 电池项目水耗低于 1700 吨/MWp。

（四）其他生产单耗需满足国家相关标准。

四、环境保护

（一）新建和改扩建光伏制造项目应严格执行环境影响评价制度，未通过环境影响评价审批的项目不得开工建设。按照环境保护“三同时”要求，项目配套建设环境保护设施应依法申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产运行。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度，定期开展清洁生产审核。

（二）废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求；恶臭污染物排放应符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554)，对产生的工业固体废物要依法贮存、处置或综合利用，应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18559)相关要求，SiCl₄等危险废物应委托具备相应处理能力的有资质单位进行妥善处置；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

（三）鼓励企业通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14064 温室气体核证、PAS2050/ISO14067 碳足迹认证。

（四）光伏制造项目应按照环境影响报告书（表）及其批复、国家或地方污染物排放（控制）标准、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，开展自行监测工作，公开自行监测信息。

五、质量管理

（一）光伏制造企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员。电池及电池组件生产企业应配备 AAA 级太阳模拟器、高低温环境试验箱等关键检测设备，鼓励企业建设具备 CNAS 认可资质的实验室。

（二）光伏产品质量应符合国家相关标准，通过国家批准相关认证机构的认证。

（三）企业应通过 ISO9001 质量管理体系认证，组件使用寿命不低于 25 年，质保期不少于 10 年。

（四）企业应建立相应的产品可追溯制度。

六、安全、卫生和社会责任

（一）光伏制造项目应当严格遵循职业病危害防护设施和安全设施“三同时”制度要求。企业应当遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，执行保障安全生产的国家标准或行业标准，在申报规范名单当年及上一年度未发生较大及以上生产安全事故。

（二）企业应当建立健全安全生产责任制，加强职工安全生产教育培训和隐患排查治理工作，开展安全生产标准化建设并达到三级以上。

（三）企业应当依法落实职业病危害防治措施，对重大危险源有检测、评估、监控措施和应急预案，并配备必要的器材和设备。

（四）企业应当遵守国家相关法律法规，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。

七、监督与管理

（一）新建和改扩建光伏制造企业及项目应当符合本规范条件要求。

（二）现有光伏制造企业及项目应当符合本规范条件要求，未满足规范条件要求的企业及项目根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达到本规范条件的要求。

（三）对光伏制造企业及项目的投资、土地供应、环评、节能评估、质量监督、安全监管、信贷授信等管理应依据本规范条件。不符合本规范条件的企业及项目，其产品不得享受出口退税、国内应用扶持等政策支持。

（四）光伏制造企业应对照规范条件编制相关申报材料，通过省级工业和信息化主管部门报送工业和信息化部。各级

工业和信息化主管部门会同有关部门对当地光伏制造企业执行本规范条件的情况进行监督检查。工业和信息化部组织行业机构、检测机构对企业进行检查，定期公告符合本规范条件的企业名单，并会同有关部门组织行业机构、检测机构从市场上对已公告企业产品等进行抽查，实行社会监督、动态管理。

（五）公告企业有下列情况，将撤销其公告资格：

1. 填报资料有弄虚作假行为；
2. 拒绝接受监督检查；
3. 不能保持规范条件要求；
4. 发生重大安全和污染责任事故；
5. 违反法律、法规和国家产业政策规定。

（六）有关行业协会、产业联盟、检测机构要协助行业主管部门做好本规范条件的实施和跟踪监督工作，组织企业加强协调和自律管理。

八、附则

（一）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有类型的光伏制造企业，本规范条件所指的光伏制造行业主要为光伏用多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池、电池组件等制造行业。

（二）本规范条件涉及的法律法规、国家标准和行业政策若进行修订，按修订后的规定执行。

(三) 本规范条件自发布之日起 30 日后实施，由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况和宏观调控要求会同有关部门适时进行修订。原《多晶硅行业准入条件》（工联电子[2010]第 137 号）同时废止。